# 量子物理部分

### 普朗克能量子假说:

辐射黑体中分子、原子的振动可看作谐振子。

振子能量的最小能量单元是"能量子"

对于频率为 $\nu$ 的谐振子能量子为  $\varepsilon = h\nu$ 

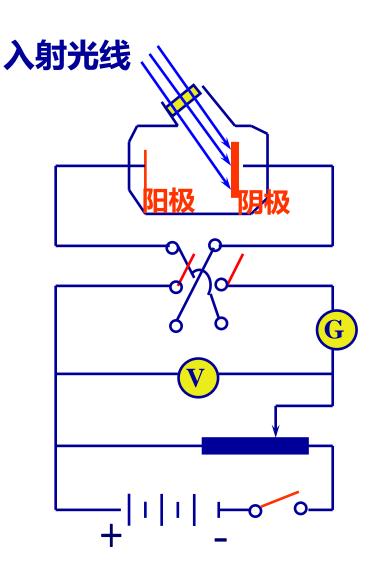
振子能量E 只能是能量子  $\varepsilon$  的整数倍,

即:  $E=n\varepsilon=nh\nu$ , n为正整数。

### ★★光电效应

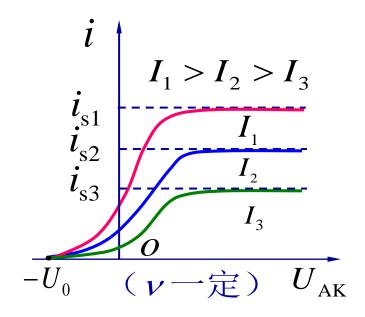
金属板释放的电子称为光电子。

光电子在电场作用 下在回路中形成<u>光</u> 电流。



## (1) 饱和电流

在单色光照射下,饱和电流 $I_H$ 随着光强度的增加而增大。



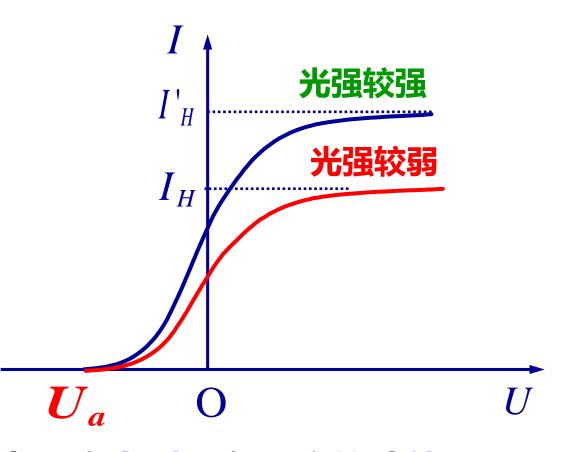
光电效应的伏安特性 曲线

## (2) 遏止电势差

①存在遏止电势差 $U_a$ 。

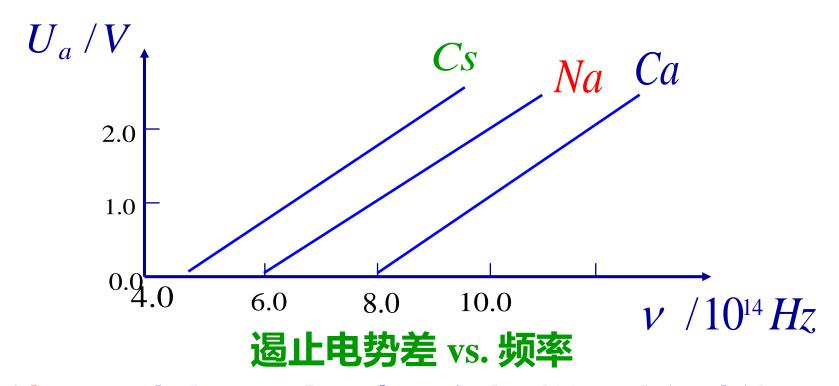
$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_a$$

②遏止电势差 $U_a$ ,与光的强度无关。



结论2: 光电子从金属表面逸出时具有一定的动能; 最大初动能与入射光的强度无关。

## (3) 遏止频率 (红限)



结论3: 光电子从金属表面逸出时的最大初动能与 入射光的频率成线性关系。

当入射光的频率小于 ½ 时,不管照射光的强度多大,不会产生光电效应。

(4) 光电效应具有瞬时性。

## 爱因斯坦光子假说和光电效应方程

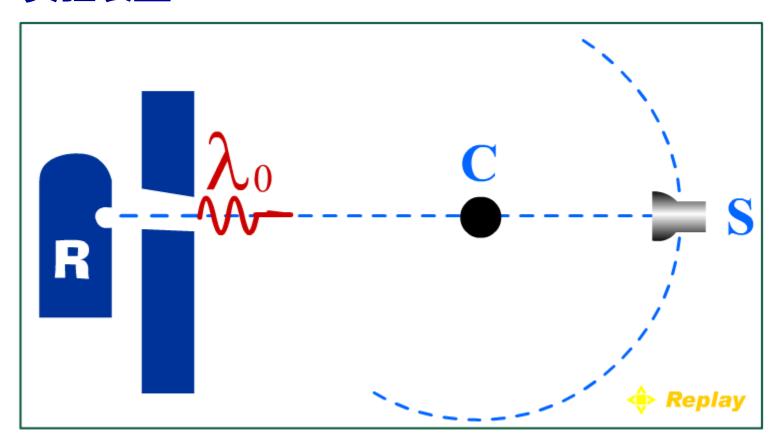
金属中的1个电子吸收1个光子,获得能量 $h\nu$ 。如果  $h\nu$ 大于逸出功A,则电子可以从金属中逸出。

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

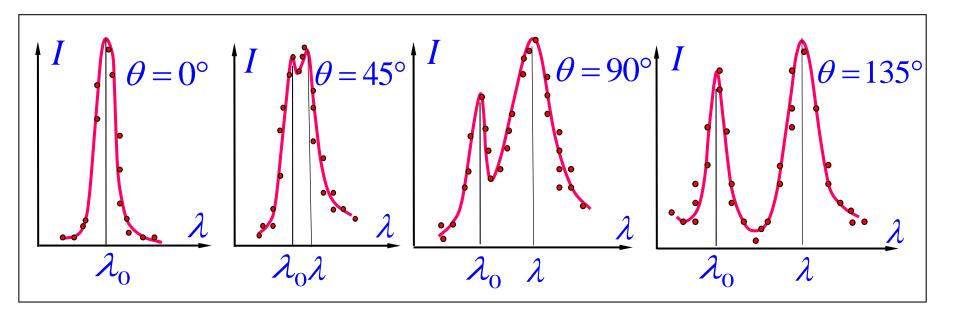
★★爱因斯坦光电效应方程

# 康普顿散射

### 实验装置



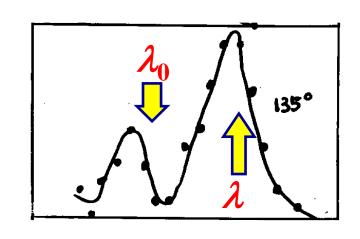
## ★ 实验规律



- ➤ 出现了移向长波方向的新的散射波长
- 一元素越轻,波长变大的散射线相对越强。

### ★光子理论的康普顿效应解释

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{c}{v} - \frac{c}{v_0}$$
$$= \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$$



### 光量子理论

碰撞过程满足能量、动量守恒

- 若光子和外层电子相碰撞,光子有一部分能量传给电子,散射光子的能量减少,
- ∴频率减小,波长增大 (<sup>1</sup>)。
- ·若光子和内层束缚电子相碰撞,光子将与整个原子交换能量。:光子质量远小于原子质量,:碰撞前后光子能量几乎不变,波长不变(%)。

## ★★玻尔的氢原子理论(1913)

## (1) 定态假设

原子系统只能处在一系列不连续的能量状态。在这些状态中,电子绕核作圆周运动,但并不辐射电磁波。

——原子的稳定状态(简称定态)

相应的能量分别为  $E_1, E_2, E_3$  , ...

### (2) 量子跃迁和频率条件

当原子从能量为  $E_n$  的定态跃迁到能量为  $E_k$  的定态时,要发射或吸收一个频率为  $\nu_{kn}$  的光子。

$$v_{kn} = \frac{\left| E_n - E_k \right|}{h}$$
 玻尔频率公式

## (3) 角动量量子化条件

## 电子绕核作圆周运动,其定态必须满足

$$L = n \frac{h}{2\pi} = n \frac{\hbar}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

n: 量子数 ħ 约化普朗克常量

# 电子在第 n 个轨道上运动,系统能量 $E_n$ 为:

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$n = 1, E_1 = -13.6 \,\mathrm{eV}$$

n > 1 的各稳定态,称为受激态;

例题: 在气体放电管中,用<u>能量为12.5eV的电子</u>通过碰撞使氢原子激发。问受激发的原子向低能级跃迁时,能发射那些波长的光谱线?

解: 设氢原子吸收电子能量后,最高能激发到第n个能级,此能级的能量为  $-\frac{13.6}{n^2}eV$ ,

$$\therefore E_n - E_1 = 13.6 - \frac{13.6}{n^2} = 12.5 \text{eV}$$

$$n^2 = \frac{13.6}{13.6 - 12.5} = 12.36$$

$$\therefore n = 3.5$$
(n只能取整数)

∴氢原子最高能激发到 n=3能级。也能激发到n=2能级。

### 实物粒子的波粒二象性

## 它的波长 $\lambda$ 、频率 $\nu$ 与E、p的关系与光子一样:

$$E = hv, p = \frac{h}{\lambda}$$

$$v = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}.$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}.$$

与粒子相联系的波称为物质波,或德布罗意波。

λ - 德布罗意波长 (de Broglie wavelength)

## 海森伯坐标和动量的不确定度关系式

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}.$$

a. 微观粒子不可能同时具有确定的动量及位置。

$$\Delta x \downarrow$$
,  $\Delta p_x \uparrow$  对于微观粒子运动, "轨道"概念  
失去了意义。

b. 不确定性关系,是微观粒子固有属性决定的,与 仪器的精度和测量方法的缺陷无关。

★★波函数 
$$\Psi(\vec{r},t)$$

波函数模的平方: 
$$\left| \Psi(\vec{r},t) \right|^2 = \Psi(\vec{r},t)^* \cdot \Psi(\vec{r},t)$$

代表 t 时刻,在  $\vec{r}$  处的 单位体积 中,发现粒子的概率

单值性: 波函数应单值,从而保证概率密度在任意时刻、任意位置都是确定的。

归一性: 粒子在空间的概率的总和必须为1。

归一化条件 
$$\iiint_{\Phi_{\mathbb{R}}} |\Psi(\vec{r},t)|^2 dV = 1.$$

有限性: 在空间任何有限体积元  $\Delta V$  中找到粒子

的概率 
$$(\iiint |\Psi|^2 dV)$$
 必须为有限值。

连续性: 要求波函数是连续的。

## 波函数性质的运用:例 作一维运动的粒子被束缚在

0 < x < a 范围内。已知其波函数为:  $\Psi(x) = A \sin(\pi x / a)$ .

试求常数 A。

由归一化条件:  $\iiint |\Psi(\vec{r},t)|^2 dV = 1.$   $\int_0^a A^2 \sin^2(\pi x/a) dx = 1 \implies A = \sqrt{\frac{2}{a}}$ 

试求 粒子在 0 到 a/2 区域出现的概率?

粒子的概率密度为:  $|\Psi(x)|^2 = \frac{2}{a}\sin^2\frac{\pi x}{a}$ ,

在 0 < x < a/2 区域内,粒子出现的概率为:

$$\int_0^{a/2} |\Psi(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{a/2} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{1}{2}.$$

## 粒子在何处出现的概率最大?

粒子的概率密度为: 
$$|\Psi(x)|^2 = \frac{2}{a}\sin^2\frac{\pi x}{a}$$
,

概率最大的位置应满足:  $\frac{d |\Psi(x)|^2}{dx} = 0.$ 

$$\therefore \sin \frac{2\pi x}{a} = 0 \quad \therefore \frac{2\pi x}{a} = k\pi, \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots$$

 $\because 0 < x < a$ ,  $\therefore x = \frac{a}{2}$  处粒子出现的概率最大。

### ★★量子化条件和量子数

### (1) 能量量子化和主量子数

$$E_{n} = -\frac{m e^{4}/(4\pi\varepsilon_{0})^{2}}{2\hbar^{2}} \frac{1}{n^{2}} = -\frac{m e^{4}}{8\varepsilon_{0}^{2}h^{2}} \frac{1}{n^{2}}, n = 1, 2, 3, ...$$

$$= -13.6 \frac{1}{n^{2}} \text{ (eV)}. \qquad n \text{ $\pi$}; \text{ $\underline{\pm}$} \text{ $\underline{\pm}$} \text{ $\underline{\pm}$} \text{ $\underline{\pm}$}$$

### (2) 轨道角动量量子化和角量子数

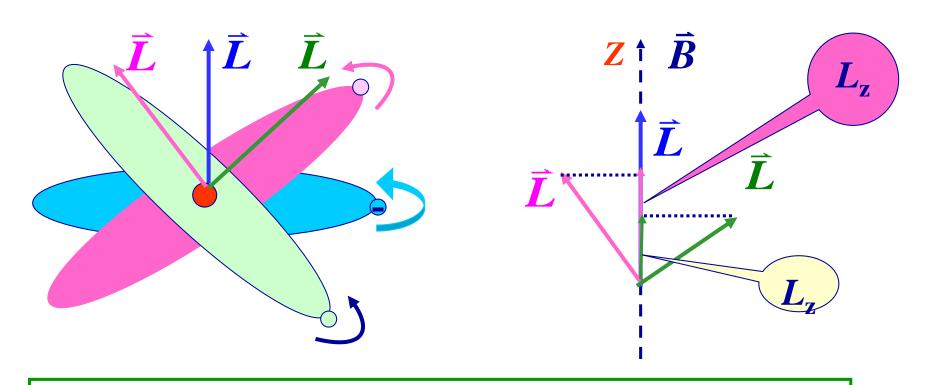
$$L = \sqrt{l(l+1)} \ \hbar, \quad \not \pm \ \psi \qquad l = 0,1,2,3,...(n-1)$$

1: 称 为角量子数,或副量子数。

处于能级  $E_n$  的原子,其角动量共有 n 种可能值,即 l=0,1,2,...,n-1,用s,p,d,...表示角动量状态。

# (3) 轨道角动量空间量子化和磁量子数

氢原子中的电子,绕核运动的角动量  $\bar{L}$  ,不仅大小 L 是量子化的,其空间取向也是量子化的。



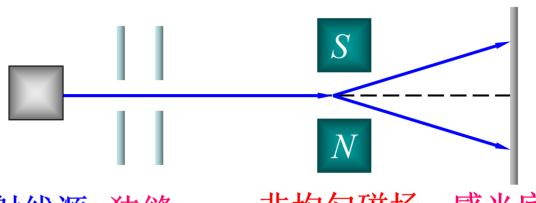
$$L_z = m_l \hbar$$
,  $m_l = 0, \pm 1, ..., \pm l$ ,  $m_l$  为磁量子数。

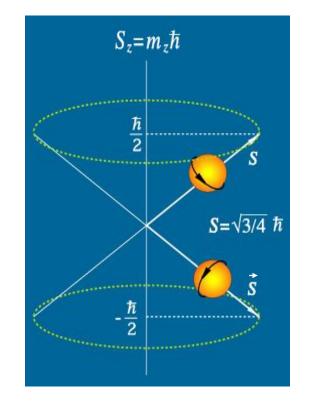
对于一定的角量子数 l,  $m_l$  可以取 (2l+1) 个值。

### (4) 施特恩——盖拉赫实验 与 电子的自旋

## 证明了空间量子化的存在

原子沉积层不是连续一片,而是分立的线,说明空间量子化的存在。





银射线源 狭缝

非均匀磁场 感光底片

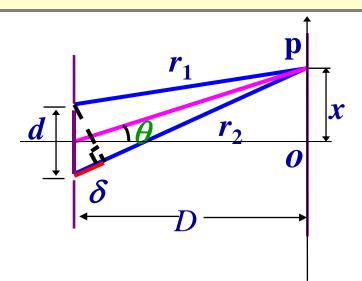


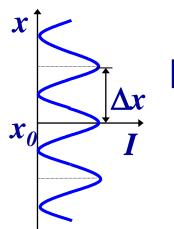
# ★ ★四个量子数

## 原子中电子的状态由<mark>四</mark>个量子数确定:

- (1)主量子数 n=1,2,3,... 大体决定电子在原子中的能量
- (2)角量子数 l = 0, 1, 2, ..., (n-1)决定电子绕核运动的角动量  $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$
- (3) 磁量子数  $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l$  决定电子绕核运动角动量的空间取向
- (4)自旋磁量子数  $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 决定电子自旋角动量的空间取向

# 波动光学部分





明纹 (中心) 位置 
$$x_{ij} = \pm k \frac{D}{d} \lambda, k = 0,1,2...$$

# 暗纹(中心)位置

$$x_{\text{H}} = \pm (k + \frac{1}{2}) \frac{D}{d} \lambda, k = 0, 1, 2...$$

## 干涉相长

$$\delta = d \cdot \frac{x}{D} = \pm k\lambda$$

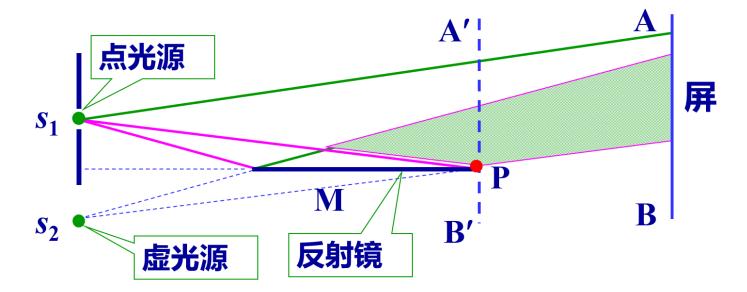
## 干涉相消

$$\delta = d \cdot \frac{x}{D} = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

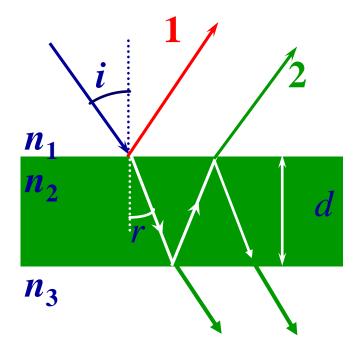
# 相邻明纹(或暗纹)间距

$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$$
 介质  $\lambda_n = \frac{\lambda}{n}$ 

### 洛埃镜实验

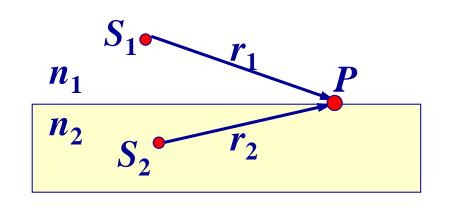


如果光从光疏媒质传向光密 媒质,在其分界面上反射时 将发生半波损失。 折射波无半波损失。



光程: L = nr

# 两列光波在P点引起的振 动的相位差:



$$\Delta \phi = \frac{2\pi r_2}{\lambda_2} - \frac{2\pi r_1}{\lambda_1} = \frac{2\pi n_2 r_2}{\lambda_0} - \frac{2\pi n_1 r_1}{\lambda_0} = \frac{2\pi n_2 r_2}{\lambda_0} - \frac{2\pi n_1 r_1}{\lambda_0} = \frac{2\pi n_2 r_2}{\lambda_0} - \frac{2\pi n_1 r_1}{\lambda_0}.$$

$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$$

∴ 相位差和光程差的关系:  $\Delta \phi = \frac{\delta}{\lambda} 2\pi$ 

相当于把光 在不同介质 中的传播都 折算成在真 空中的传播

### 等厚干涉

光程差: 
$$\delta = 2n_2 d \cos r + \delta'$$
 或  $\delta = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$ 

$$\delta = 2n_2 d + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3 \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2 \end{cases}$$

$$k = 1, 2, 3$$

明纹

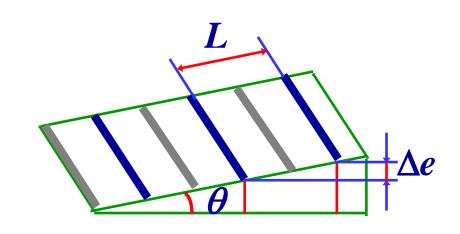
$$k = 0, 1, 2$$

### 暗纹

## 相邻明纹(或暗纹)的间距

$$L = \Delta e / \sin \theta$$

$$\approx \Delta e/\theta \approx \lambda/2n\theta$$



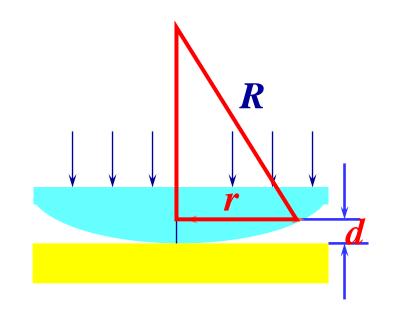
- a. 条纹等间距分布
- b. 夹角 θ 越小, 条纹越疏; 如 θ 过大, 条纹将密集到 难以分辨,就观察不到干涉条纹了。

### ★牛顿环干涉

$$(R-d)^2 + r^2 = R^2$$

$$R^2 - 2Re + d^2 + r^2 = R^2$$

$$d = r^2/2R$$



### 光程差?

$$\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3 \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2 \end{cases}$$
 暗纹

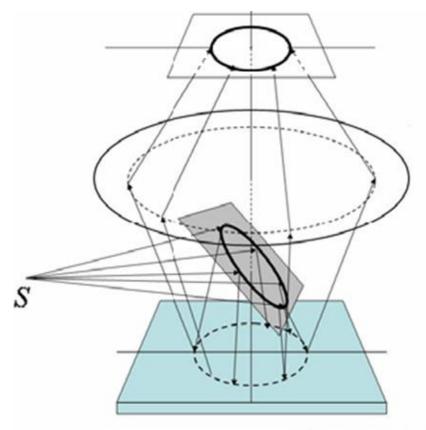
明暗环: 
$$r_{\rm H} = \sqrt{(k-1/2)R\lambda}$$
  $r_{\rm H} = \sqrt{kR\lambda}$ 

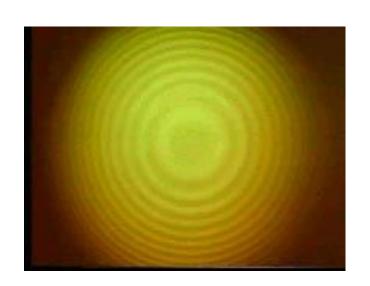
得: 
$$r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$$

# 明(暗)条纹

$$\delta = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$\delta = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = (k + \frac{1}{2})\lambda$$





·条纹级次分布: 越靠近中心,条纹级次k 越高。

# 例:在玻璃表面镀上一层MgF2薄膜,使波长为1=

5500 Å的绿光全部通过。求: 膜的厚度。

## 解一: 使反射绿光干涉相消:

# 由反射光干涉减弱条件:

$$\delta = 2 n_2 e = (2k+1) \lambda_{\mathcal{A}} / 2,$$

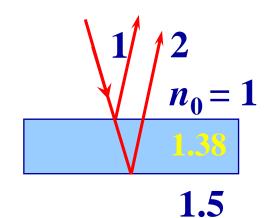
$$\therefore e = \frac{(2k+1)\lambda_{\$}}{4n_2}$$

取
$$k = 0$$
,  $e = \frac{\lambda_{\$}}{4n_2} = \frac{5500}{4 \times 1.38}$ 
$$= 996(\text{Å})$$

$$n_0 = 1$$

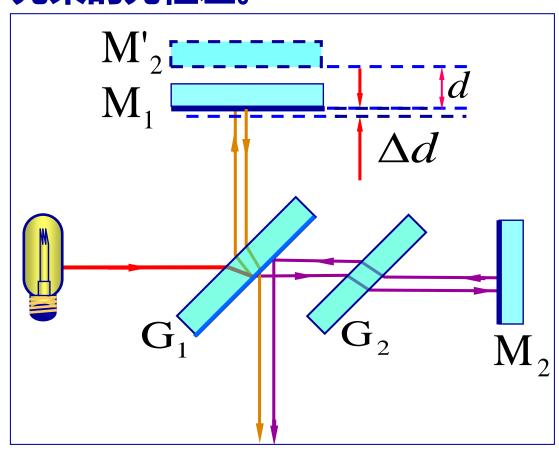
MgF <sub>2</sub>	$n_2 = 1.38$
------------------	--------------

玻璃 
$$n_1 = 1.50$$

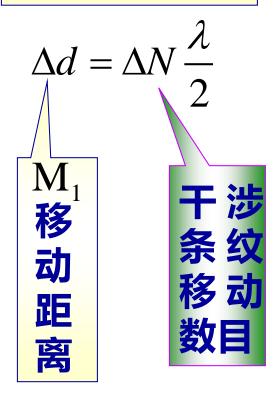


### 迈克尔逊干涉仪

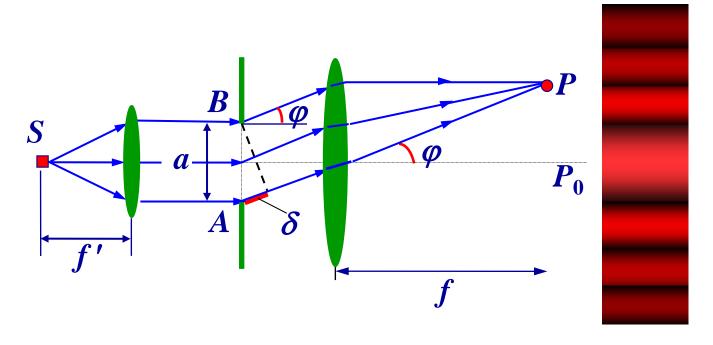
## 并可用移动反射镜或在光路中加入介质片的方法改变两 光束的光程差。



## 移动反射镜



## ★单缝夫朗禾费衍射

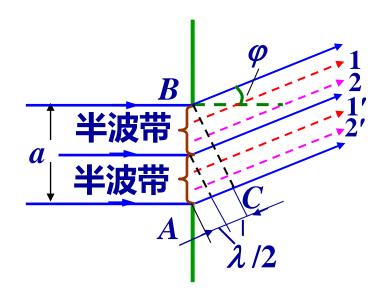


S: 单色线光源  $\overline{AB} = a$  : 缝宽,  $\varphi$ : 衍射角

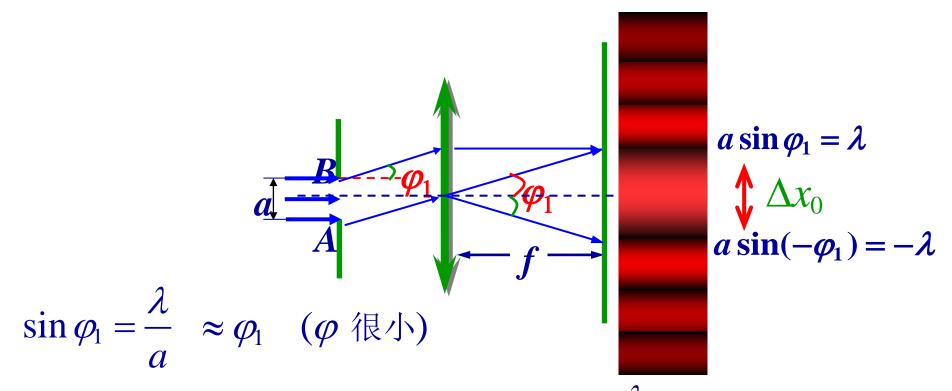
### ★ ★半波带法

在波阵面上截取一个条状带,使它上下两边缘发的光在屏上P处的光程差为  $\lambda/2$  ,此带称为半波带。

• 当  $a \sin \varphi = \lambda$  时,可将狭缝分为两个"半波带"



两相邻半波带上的对应点发的光在P 处,光程差始终相差 $\lambda/2$ ,干涉相消,形成暗纹。



中央明纹的角宽度为:

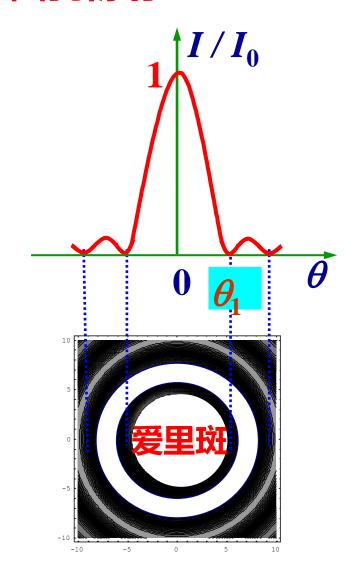
$$\Delta \varphi_0 = 2\varphi_1 \approx 2\frac{\lambda}{a}$$

中央明纹的线宽度为:

$$\Delta x_0 = 2 \cdot f \cdot \tan \varphi_1 \quad \Box \ 2 \cdot f \cdot \varphi_1 \quad \Box \ 2 f \frac{\lambda}{\alpha} \propto \frac{\lambda}{\alpha}$$

次级明纹的线宽度为:  $\Delta x \approx f \frac{\lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta x_0$ .

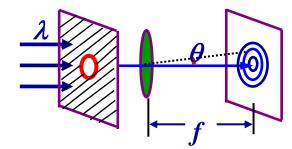
## 圆孔衍射



 $\theta_1$ : 第1级暗纹的衍射角,也是 爱里斑的角半径。

$$\sin \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D} \approx \theta_1 \quad (\theta 很小)$$

爱里斑的半径:



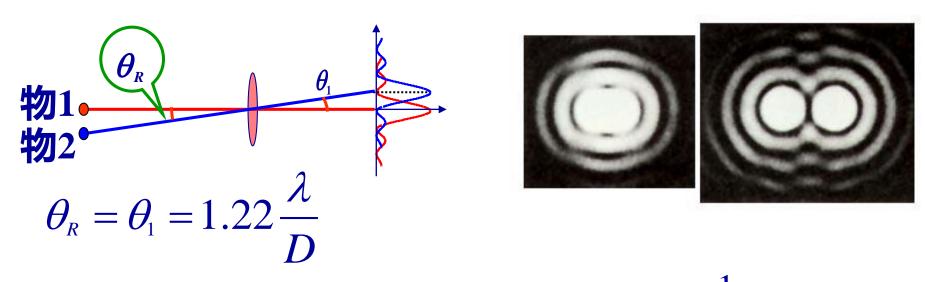
$$R = f \cdot \tan \theta_1 \approx f \cdot \theta_1 \approx 1.22 \frac{\lambda}{D} f.$$

 $D\downarrow$ ,  $\lambda\uparrow$  爱里斑越大,衍射现象越明显

 $D>>\lambda$ , 爱里斑小,衍射现象 可忽略。

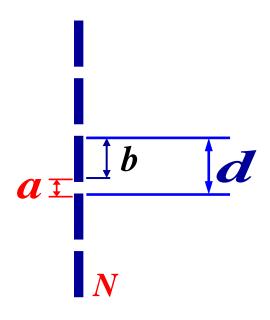
## 分辨率问题

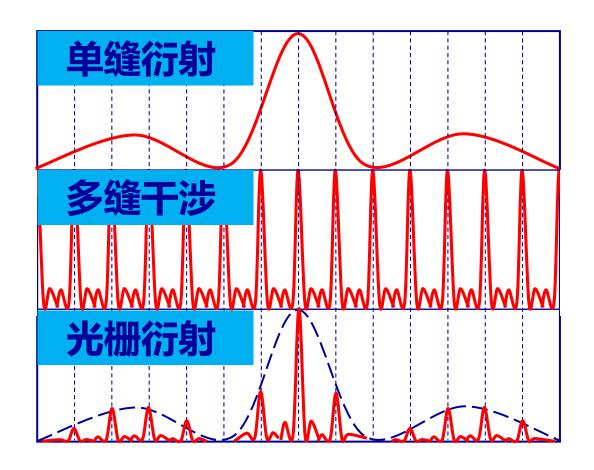
能分辨的两物体在透镜处所张的角,称为最小分辨角, $\theta_R$ 。



分辨本领 (率): 最小分辨角的倒数。  $R = \frac{1}{\theta_R}$ 

# ★ ★光栅衍射





a: 透光部分的宽度; N: 透射光栅的总缝数;

b: 不透光部分的宽度; d = a+b: 光栅常量

## ★ 明纹条件:

$$(a+b)\sin\varphi = \pm k\lambda, k = 0, 1, 2, \cdots$$

——★光栅方程

## ★ 暗纹条件:

$$(a+b)\cdot\sin\varphi=\pm m\;\frac{\lambda}{N},\qquad (m=1,2,3,\cdots)$$

(m不等于N的整数倍)

相邻主极大间有 N-1 个暗纹;有 N-2 个次极大。

★ 看到的衍射条纹级次:  $|\sin \varphi| \le 1$ 

$$k = \frac{(a+b)\sin\varphi}{\lambda} < \frac{a+b}{\lambda}$$

同时考虑缺级

#### ★ 缺级计算

#### 对于满足光栅方程的主极大条纹

$$\delta = (a+b) \sin \varphi = \pm k\lambda$$
  $k = 0,1,2,3 \cdots$ 

$$k=0,1,2,3\cdots$$

#### 若衍射角同时也满足单缝衍射的暗纹条件,

$$a \sin \varphi = \pm k' \lambda$$

$$k' = 1,2,3 \cdots$$

#### 则相应的主极大级数就会发生缺级,

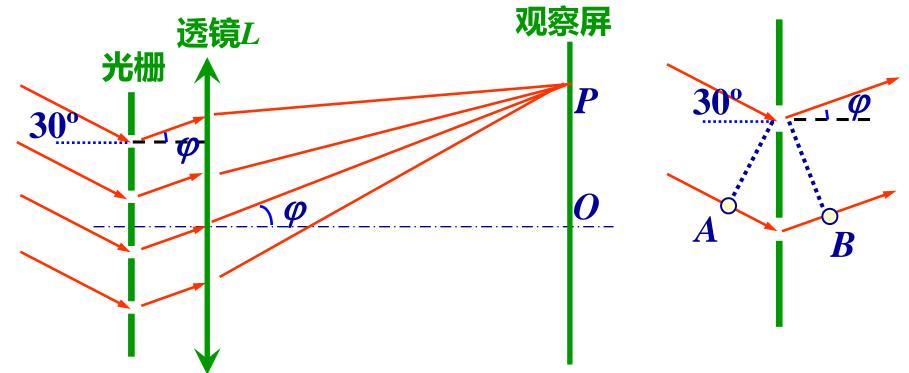
$$\frac{k}{k'} = \frac{a+b}{a} = \frac{d}{a}$$

$$k = \left(\frac{d}{a}\right)k \quad (k' = 1, 2, 3, \dots)$$

( 若
$$d = 4a$$
 ) 缺  $\pm 4, \pm 8, \dots$  级

#### 倾斜入射情况的处理方法

若平行光斜入射,光程差的计算应做调整。



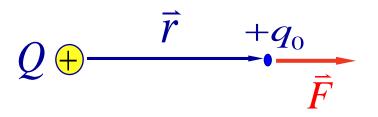
在 $\varphi$ 方向上,穿过相邻狭缝的两束光的光程差为:

 $\delta = d \cdot \sin 30^{\circ} + d \cdot \sin \varphi = d \cdot (\sin 30^{\circ} + \sin \varphi)$ 

#### 静电场

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \vec{E}(x, y, z)$$

### 单个点电荷 + Q的电场

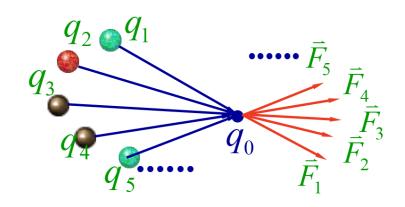


$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{Q}{4 \pi \varepsilon_0 r^3} \vec{r}$$

#### ★场的叠加原理

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_{i} = \vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{n}$$

点电荷系在空间任一点所 激发的总场强等于各个点 电荷单独存在时在该点各 自所激发的场强的矢量和



注意: 矢量的叠加

### 电荷连续分布带电体的电场强度

#### 处理方法: 可以将带电体分割成许多 "电荷元"

$$d\vec{E} = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{dq}{r^3} \vec{r}$$

$$d\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \int \frac{dq}{r^3} \vec{r}$$

$$dq$$

$$d\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \int \frac{dq}{r^3} \vec{r}$$

#### 场强 E 表达式:

$$\vec{E} = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \iiint_{v} \frac{\rho dV}{r^3} \vec{r} \qquad \vec{E} = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \iint_{s} \frac{\sigma dS}{r^3} \vec{r} \qquad \vec{E} = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \int_{l} \frac{\lambda dl}{r^3} \vec{r}$$

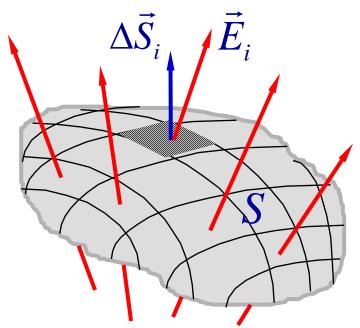
体电荷分布 面电荷分布

线电荷分布

# ★电通量 (电场强度通量)

电场中,穿过面积 S 的电场线的总条数,——(穿过该面的)电通量  $\psi_E$ 

$$\Psi_E = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



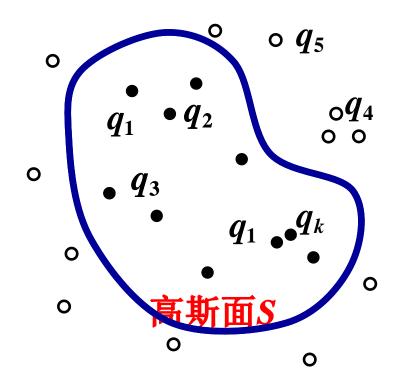
★★高斯定理:在真空中,静电场通过任意闭合曲面的电通量,等于面内所包围的自由电荷代数和除以真空介电常数。

$$\Psi_e = \oiint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S \nmid i} q_i$$

#### 点电荷系

$$\Psi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \cdot dV$$

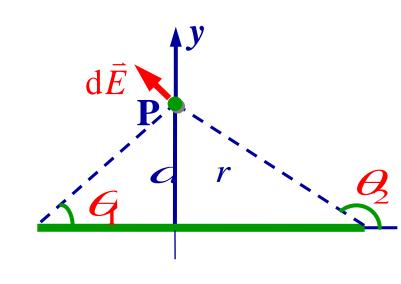
连续分布带电体



# 例:长为L的直导线的电场

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi \, \varepsilon_0 a} (\sin \, \theta_2 - \sin \, \theta_1)$$

$$E_{y} = \frac{\lambda}{4\pi \, \varepsilon_{0} a} (\cos \theta_{1} - \cos \theta_{2})$$



$$\begin{array}{c} \bullet \\ \theta_1 \rightarrow 0 \\ \theta_2 \rightarrow \tau \end{array}$$

当直线长度 
$$L \to \infty$$
 
$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_1 \to 0 \\ \theta_2 \to \pi \\ \end{array} \right.$$

$$E_x = 0 \quad E_y = \frac{\lambda}{4\pi \, \epsilon_0 a} \times 2 = \frac{\lambda}{2\pi \, \epsilon_0 a}$$

# 无限长均匀带电直线的场强:

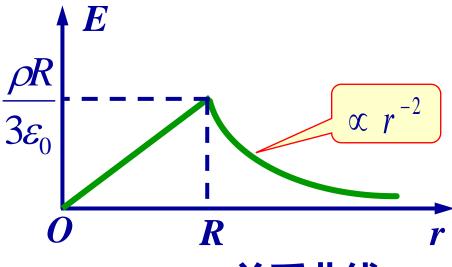
$$E = E_y = \frac{\lambda}{2\pi \, \varepsilon_0 a}$$

例:均匀带电球体的电场。球半径为R,体电荷密度

为 $\rho$ 。求周围空间电场强度E的分布。

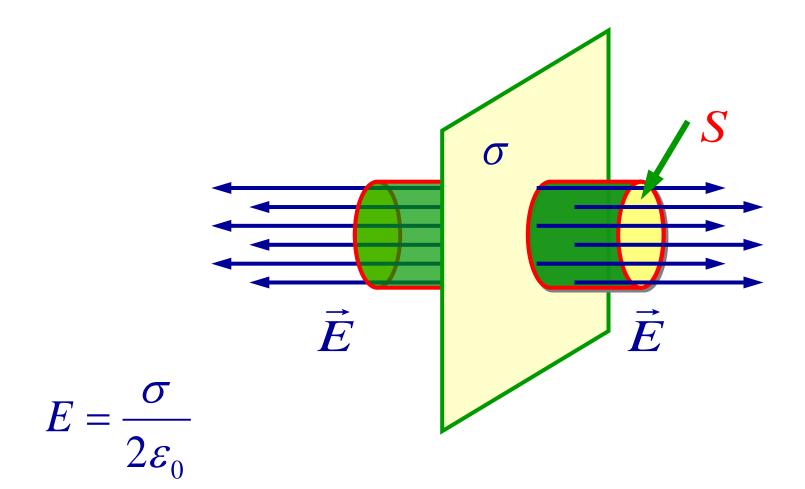
### 均匀带电球体的电场分布

$$E = \begin{cases} \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r \\ \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \end{cases}$$



E-r 关系曲线

# 例: 均匀带电无限大平面的电场。



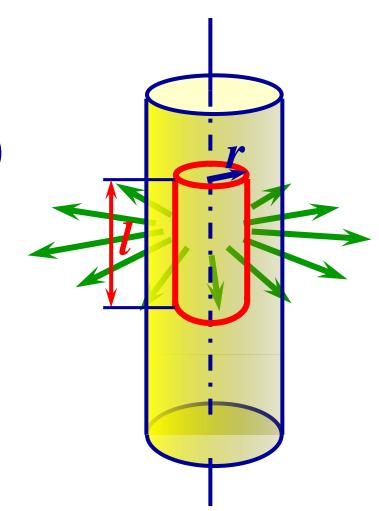
例: 无限长均匀带电圆柱面的电场。圆柱半径为

R,沿轴线方向单位长度带电量为 $\lambda$ 。

(1) 
$$r < R$$
  $r < R$   $r < R$ 

(2) 当r > R 时,

$$\sum q = \lambda l \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$



# ★静电场的环路定理

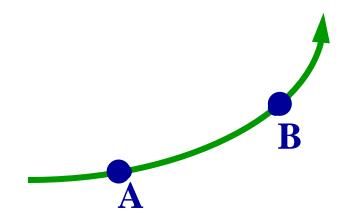
$$\iint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

在静电场中,场强沿任意闭合路径的线积分 (称为场强的<mark>环流</mark>) 恒为零。

# 某点电势能 $W_A$ 与 $q_0$ 之比只取决于电场,定义为该点的电势

$$u_A = \frac{W_A}{q_0} = \int_A^0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势零点的选取是任意的。



### 电势差

$$u_{AB} = \frac{W_A}{q_0} - \frac{W_B}{q_0} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

# ★★ 电势叠加原理

在电荷体系的电场中,某点电势等于各电荷单独在该点产生的电势的代数和

$$u = \sum_{i} u_i$$

注意: 各电荷的<u>电势零点</u>必须相同。

电势的计 算方法:

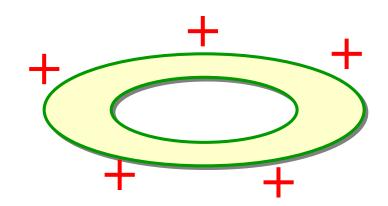
$$ightarrow$$
 利用  $u_P = \int \frac{\mathrm{d}q}{4 \, \pi \varepsilon_0 r}$ 

ightharpoonup 若已知在积分路径上  $\bar{E}$  的函数表达式,则:

$$u_A = \int_{A}^{"0"} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

#### **★空腔导体内外的静电场以及电荷分布特点**

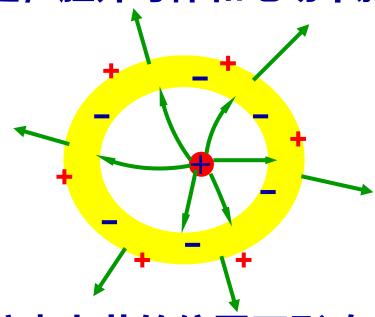
(1)腔内无带电体内表面无净电荷。



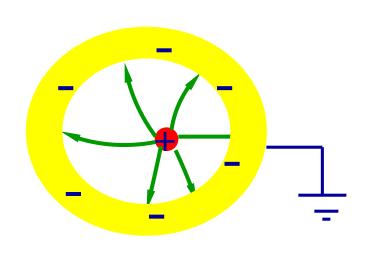
导体内部及腔体的内表面处处无净电荷。

#### (2) 腔内有带电体:

腔体内表面所带的电量和腔内带电体所带的电量等量异号, 腔体外表面所带的电量由电荷守恒定律决定, 腔外导体和电场不影响腔内电场。



腔内电荷的位置不影响 导体外电场。

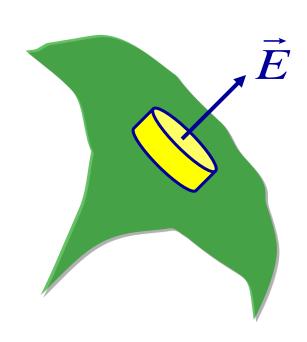


外表面接地,腔外电场消失。(导体外无电荷)

#### 导体的表面场强

# 由高斯定理可证明

$$E_{
m h, km} = rac{\sigma}{arepsilon_0}$$



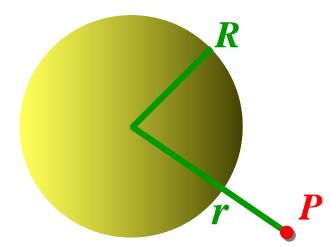
# ★ 求一均匀带电球面的电势分布,总电量为q。

#### 解:由高斯定理知,电场分布为

$$E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_o} \frac{q}{r^2} & r > R \end{cases}$$

#### 1.当r < R 时

$$u = \int_{r}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r}^{R} E \cdot dr + \int_{R}^{\infty} E \cdot dr$$
$$= \int_{R}^{\infty} \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q}{r^{2}} dr = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q}{R}$$



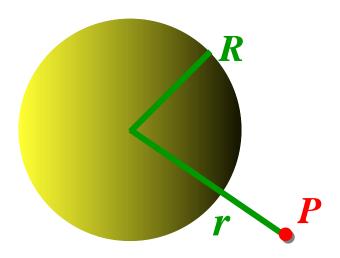
#### 2.当r > R 时

$$u = \int_{r}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_{0}} \frac{q}{r}$$

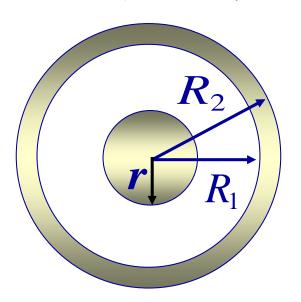
#### 3.电势分布

$$u = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R} & r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R} & r > R \end{cases}$$

$$E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_o} \frac{q}{r^2} & r > R \end{cases}$$



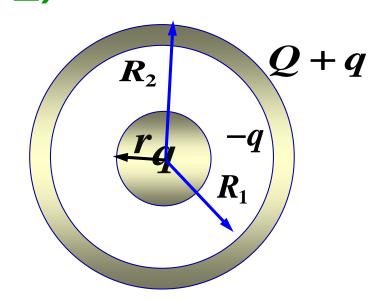
- ★在内外半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$ 的导体球壳内,有一个半径为r的导体小球,小球与球壳同心,让小球与球壳分别带上电荷量q和Q。
- 试求: (1) 小球的电势 $V_r$ , 球壳内、外表面的电势;
  - (2) 小球与球壳的电势差;
  - (3) 若球壳接地,再求小球与球壳的电势差。



#### 第二种思路(直接应用电势叠加原理)

小球球面处的电势V<sub>r</sub>,等于各个带电体单独存在时在r处激发的电势之和。

$$\begin{split} V_r = V_r(q) + V_r(-q) + V_r(Q+q) \\ = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \end{split}$$



#### 电容器的电容

电容器的电容: 
$$C = \frac{q}{U_1 - U_2}$$

q: 其中一个极板电量绝对值

 $U_1$ — $U_2$ : 两板电势差

计算电容的一般方法:

先假设电容器的两极板带等量异号电荷,再计算出 电势差,最后代入定义式。

#### 静电场的能量

# 匀强电场的电场能量密度为

$$w_{\rm e} = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

#### 任一带电体系的电场总能量

$$W = \int w_{\rm e} dV = \iiint_V \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV$$

# 电位移矢量:

$$\vec{D} \equiv \varepsilon \vec{E}$$

# D 的高斯定理:

$$\iint_{S} \overline{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i} q_{0}$$

通过任意封闭曲面的电位移矢量的通量, 等于该封闭面所包围的自由电荷的代数和

#### 恒定电流的磁场

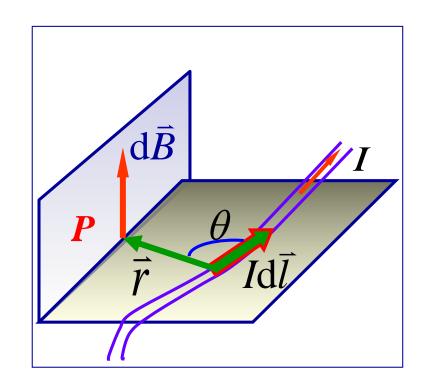
# 毕奥—萨伐尔 (Biot-Savart) 定律

#### 磁感应强度的矢量式:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

#### P点的总磁感应强度

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{I \, \mathrm{d} \, \vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



# ★★重要结论 载流长直导线的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

(1) 无限长直导线  $\theta_1 \rightarrow 0$ ,  $\theta_2 \rightarrow \pi$ 

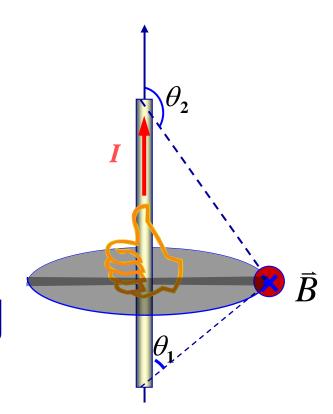
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

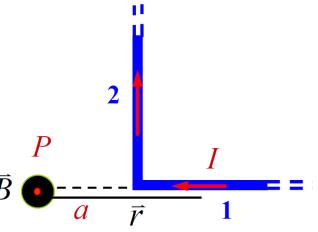
 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$  方向:右螺旋法则



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

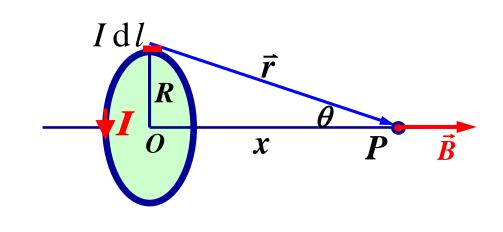
(3) P点位于导线延长线上,B=0





# 载流圆线圈轴线上的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$
$$= \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{IS}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



# 在圆心处

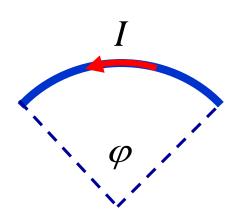
$$x = 0$$

$$x = 0 \qquad B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

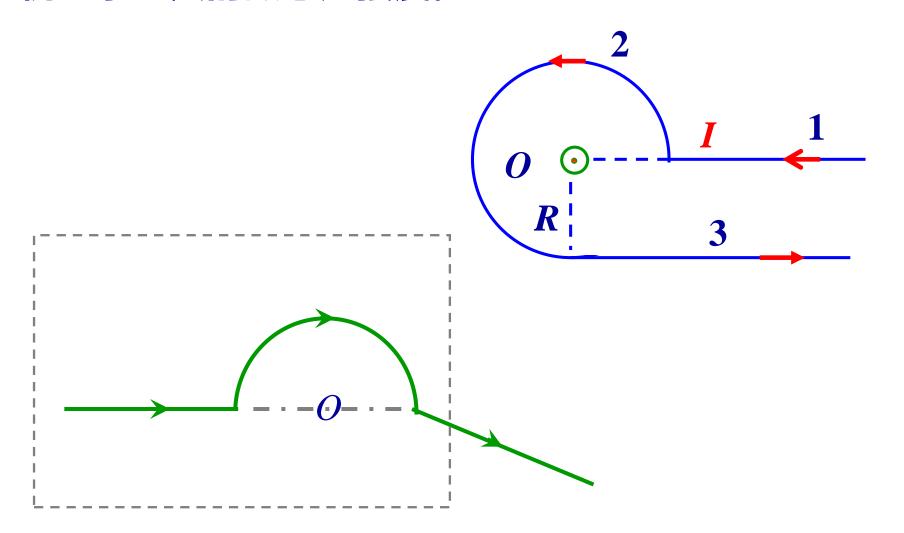
# \*一段圆弧在圆心处产生的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\varphi}{2\pi} \rightarrow B = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi R}$$

$$B = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi R}$$

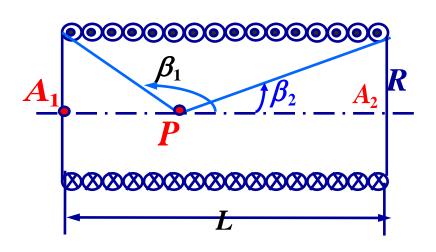


# 例:求心点的磁感应强度。



# 载流直螺线管内部的磁场

$$B = \frac{\mu_0}{2} nI(\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$



#### 螺线管无限长, $\beta_1 \rightarrow \pi, \beta_2 \rightarrow 0$

$$\beta_1 \rightarrow \pi, \beta_2 \rightarrow 0$$

$$B = \mu_0 nI$$

# ★磁通量

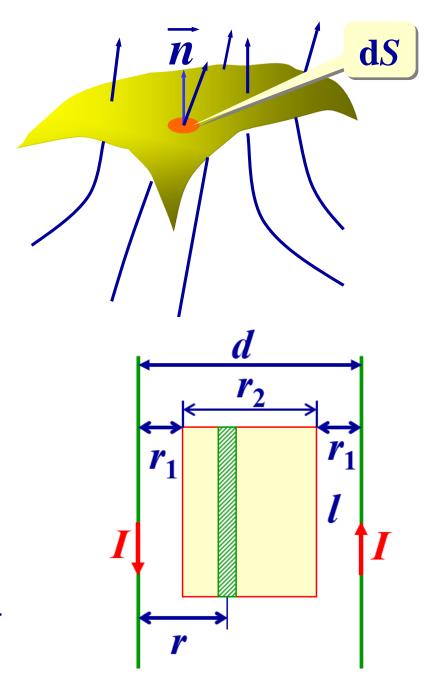
$$d\Phi = BdS\cos\theta = \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

# 对整个曲面,磁通量:

$$\Phi = \iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$B_r = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d - r)}$$

$$\Phi = \int B dS = \frac{\mu_0 Il}{\pi} \ln \frac{r_1 + r_2}{r_1}$$

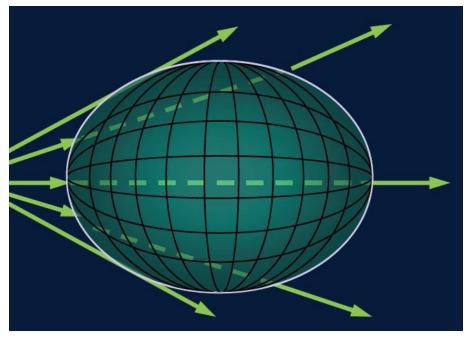


#### ★磁场的高斯定理

由磁感应线的闭合性可知,对任意闭合曲面,穿入的磁感应线条数与穿出的磁感应线条数相同,因此,通过任何闭合曲面的磁通量为零。



高斯定理的积分形式

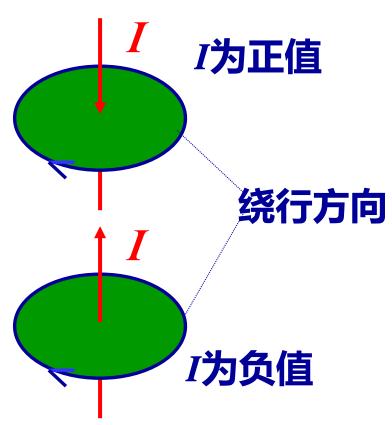


# \*\*安培环路定理

在磁场中,沿任一闭合曲线 B 量的线积分(称 B 量的环流),等于真空中的磁导率μ<sub>0</sub>乘以穿过以这闭合曲线为边界所张任意曲面的各恒定电流的代数和。

安培环路定理  $\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} \stackrel{\circ}{=} \mu_{0} \sum I$ 

电流 I 的正负规定: 积分路径的绕行方向与电流成右手螺旋关系时, 电流 I 为正值; 反之 I 为负值。



#### 长直圆柱形载流导线内外的磁场

$$\iint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{i} I$$

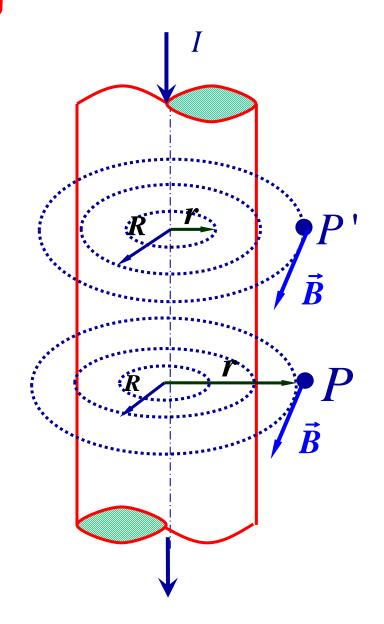
 $\mathbf{1)} \stackrel{\mathbf{d}}{=} r > R \qquad B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$ 

$$\therefore B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r}$$

 $2) \quad \overset{\boldsymbol{\mu}}{=} r < R ,$ 

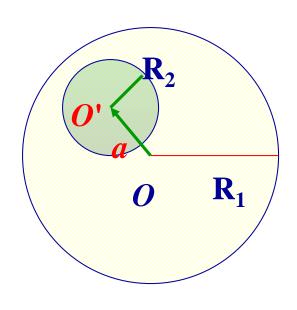
$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$$

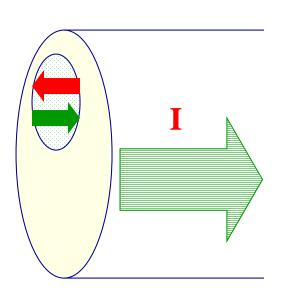
$$\therefore B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{Ir}{R^2}$$



例:半径为R<sub>1</sub>的无限长圆柱形导体管,内有半径为R<sub>2</sub>的空心,两轴线相距*a*。电流沿导体管流动,且均匀分布在横截面上,求圆柱轴线和空心轴线上任一点的磁场。

因回路不闭合,不处理无法用环路定理求解采用补偿法,将空心部分看成通有相等相反电流的实心导线。





#### 安培力

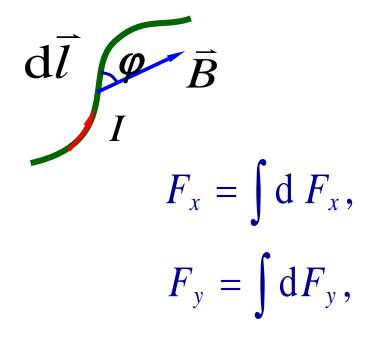
$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

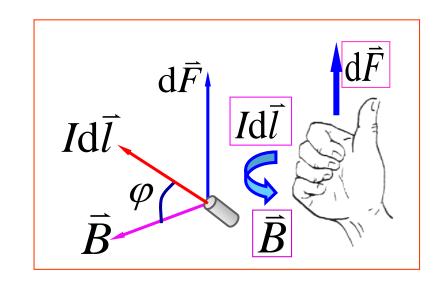
大小:  $dF=I dl B \sin \theta$ 

方向: 右手螺旋定则

#### 任意形状载流导线在外磁场中所受的安培力

$$\vec{F} = \int_{l} d\vec{F} = \int_{l} I d\vec{l} \times \vec{B}$$





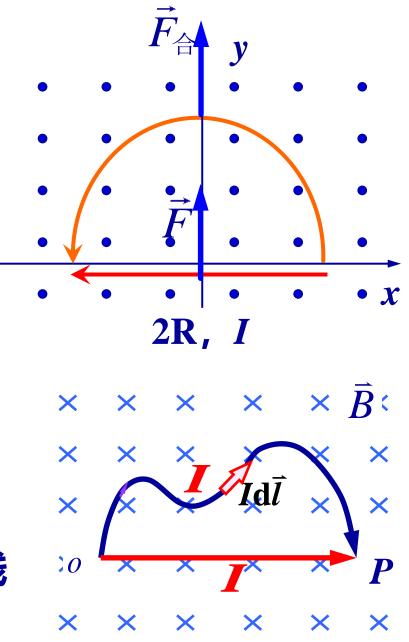
$$F_{\Leftrightarrow} = 2BIR$$
.

考虑从右端指向左端的长度为2R的电流I,

$$F = 2BIR$$
.

二 半圆形载流导线上所受的磁力,与两个端点相连的直导线所受到的磁力相等。

推广: <u>任意弯曲</u>的载流导线, 在<u>均匀磁场</u>中受到的安培力, 等效于两个端点相连的直导线 受到的安培力。



#### 磁场对载流线圈的作用

载流线圈的空间取向用电流右 手螺旋的法向单位矢量 $\hat{n}$ 描述。

设任意形状的平面载流线圈的面积为S,电流强度为I,

#### 定义线圈的磁矩:

 $\overline{m} = IS\hat{n}$ 

若线圈有N匝:  $m = NIS\hat{n}$ 

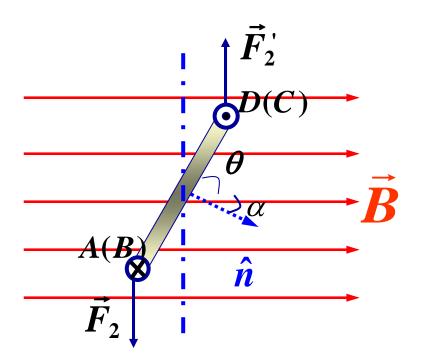
$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$
.

m

# $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

①  $\alpha = \pi/2$ ,线圈平面与磁场方向相互平行,力矩M最大。力矩有使 $\varphi$ 减小的趋势。

②  $\alpha = 0$ ,线圈平面与磁场方向垂直,力矩为零,线圈处于平衡状态。



③  $\alpha=\pi$ ,线圈平面与磁场方向相互垂直,力矩为零,但为不稳定平衡,B与m反向,微小扰动,磁场的力矩使线圈转向 $\alpha=0$ 的稳定平衡状态。

总结: 任意形状的平面载流线圈作为整体在均匀外磁场中,受到的合力为零。合力矩  $\bar{M} = m \times \bar{B}$  使线圈的磁矩 m 转到磁感应强度  $\bar{B}$  的方向。

#### 磁力的功

### 磁力所作的功为:

$$dA = Id\Phi \qquad A = \int Id\Phi$$

$$\vec{F}_2'$$
 $d(c)$ 
 $\vec{B}$ 

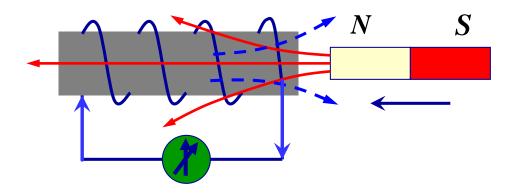
$$dA = -M d\theta = I d\Phi$$

$$A = I\Delta \Phi$$

#### 电磁感应现象

#### 楞次定律—判断方向

判断感应电流方向的楞次定律:闭合回路中产生的感应电流具有确定的方向,它总是使感应电流所产生的通过回路面积的磁通量,去补偿或者反抗引起感应电流的磁通量的变化。



# \*\*法拉第电磁感应定律

通过回路所包围面积的磁通量发生变化时,回路中产生的感应电动势  $\varepsilon_i$  与磁通量 $\Phi$ 对时间的变化率成正比.

负号 "-":

反映感应电动势的方向;与楞次定律一致。

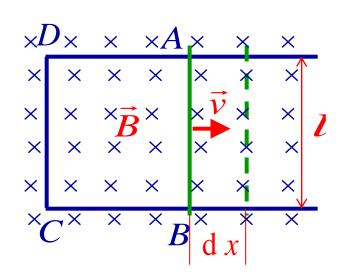
 $d \Phi / dt : \epsilon_i$  正比于磁通量变化快慢。

#### 动生电动势和感生电动势

#### ★动生电动势与洛伦兹力

# $\vec{E}_{k}$ 表示非静电场强

$$-e\vec{E}_{k} = -e\vec{v} \times \vec{B}$$



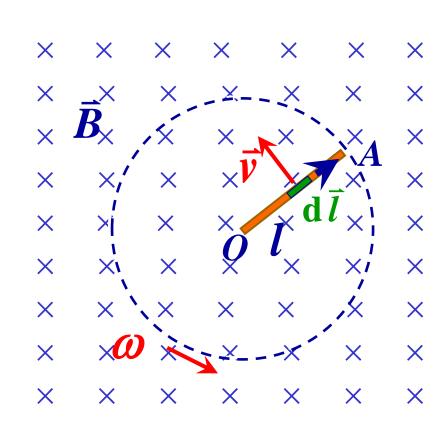
$$\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\varepsilon_{i} = \int_{A}^{B} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l} = \int_{A}^{B} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

例: 长为L的铜棒在均匀磁场  $\vec{B}$ 中,在与磁场方向垂 直的平面内以角速度 $\omega$  绕O轴逆时针匀速转动。

求:棒中的动生电动势。

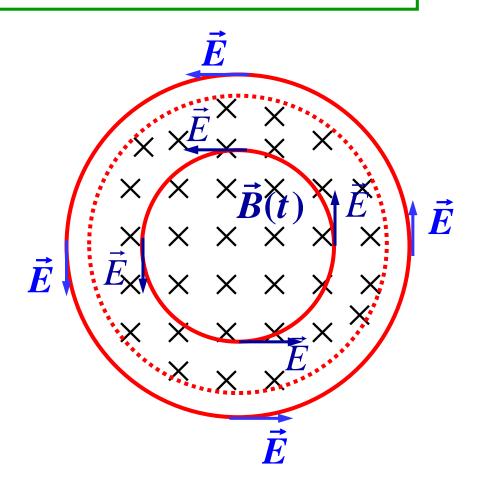
$$\varepsilon_i = \int_L \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$$



#### ★感生电场与感生电动势

# 变化的磁场在其周围激发了一种电场,这种电场称为感生电场。

$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



例题: 如图,半径为R的圆柱形体积内充满磁感应强度为 B(t)的均匀磁场,有一长为l的金属棒放在磁场中,设dB/dt为已知,求棒两端的感生电动势。

解法1: 选闭合回路Oab, 方向为逆时针

$$\varepsilon_{i} = \prod_{L} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{l} = \left(\int_{0}^{a} + \int_{a}^{b} + \int_{b}^{0}\right) \vec{E}_{i} \cdot d\vec{l}$$

$$= 0 + \int_{a}^{b} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{l} + 0 = -\frac{d\Phi}{dt}$$

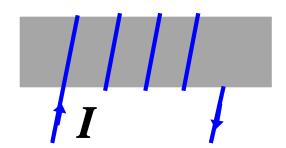
$$= \iint_{S} \frac{\partial B}{\partial t} dS = \frac{dB}{dt} \iint_{S} dS = \frac{dB}{dt} \frac{1}{2} l \sqrt{R^2 - \frac{l^2}{4}} = \varepsilon_{ab}$$

方向为 $a \rightarrow b$ 

#### 自感和互感

## ★自感应

# 自感现象

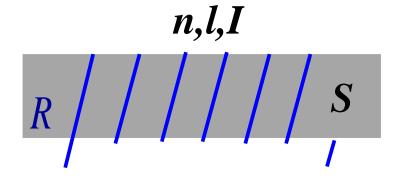


系数L (>0) —自感系数、自感  $\Psi = LI$ ,

:自感电动势: $\varepsilon_L = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ 

例: 一无铁芯的长直螺线管,长为l,截面半径为R,管上绕组的总匝数为N,其中通有电流I。

求: 长直螺线管的自感系数 L。



$$L = \frac{\Psi}{I} = \mu_0 \frac{N^2 \pi R^2}{l}.$$

# ★互感应

$$\Psi_{21} = M_{21} I_{1}$$

$$\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{dI_{1}}{dt}.$$

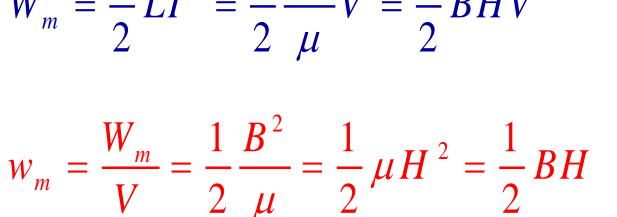
$$I_{1}$$

$$I_{2}$$

$$M_{12} = M_{21} = M$$
,  $\frac{\Psi_{12}}{I_2} = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = M$ 

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2$$

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu}V = \frac{1}{2}BHV$$



n, l